$MgAl_2O_4$ 基板上への高配向(α "+ α ')-Fe₁₆N₂薄膜のエピタキシャル成長

Epitaxial growth of highly oriented (α "+ α ')-Fe₁₆N₂ films on MgAl₂O₄ substrates

^O東小薗 創真¹、伊藤 啓太^{1,2,3}、具志 俊希¹、都甲 薫¹、末益 崇¹

(筑波大 数理物質 ¹、東北大 エ ²、学振 ³)

°S. Higashikozono¹, K. Ito^{1,2,3}, T. Gushi¹, K. Toko¹, and T. Suemasu¹

(1. Inst. of Appl. Phys., Univ. of Tsukuba, 2. Dept. of Electronic Eng., Tohoku Univ., 3. JSPS)

E-mail: bk201111036@s.bk.tsukuba.ac.jp

【背景】 α "-Fe₁₆N₂はレアアースを用いない高飽和磁化材料として注目されているが、報告される 飽和磁化の値は 1700~2300 emu/cm³と大きくばらついている¹⁴⁾。超巨大飽和磁化の真偽と起源は 未だ明らかでないが、下地との格子不整合率が飽和磁化に影響するという報告もある³⁴⁾。そこで 本研究では、 α "-Fe₁₆N₂ 薄膜の新たな成長基板として、格子不整合率が 0.08%と非常に小さい MgAl₂O₄(MAO)(001)基板に注目した。MAO(001)に加え、比較のために格子不整合率が-4.0%と大 きい MgO(001)基板上に、 α -Fe を緩衝層として(α "+ α ')-Fe₁₆N₂をエピタキシャル成長し、基板の違 いが(α "+ α ')-Fe₁₆N₂の結晶性と磁気特性に与える影響を調べた。

【実験】分子線エピタキシー法により、MAO(001), MgO(001)基板上へ、 α -Fe(3, 10 nm)を緩衝層と して α '-Fe₈Nをエピタキシャル成長した。全ての試料でFe-N層の成膜条件を揃え、基板および α -Fe の厚さのみを変えた。一部の試料で成長後に150 °Cのポストアニールを最大100時間行った。結 晶性評価に反射高速電子線回折(RHEED)、 ω -2 θ X線回折(XRD)、ロッキングカーブ測定を用いた。

【結果・考察】Fig. 1 に、各試料の as-grown での α -Fe(002)と α '-Fe-N(002)に対するロッキングカー ブの FWHM の相関を示す。正の相関が得られたことから、 α -Fe 緩衝層の配向性が Fe-N 層の配向 性に強く影響すると言える。Fe-N 層の配向性は α -Fe(3 nm)/MAO 上で最も向上した(FWHM = 0.08 deg)。Fig. 2 に、 α '-Fe₈N(97 nm)/ α -Fe(3 nm)/MAO をポストアニールした際の ω -2 θ XRD パターンの 変化を示す。アニール開始から 2 時間で α "相固有の回折ピークである α "(002), α "(006)が現れたが、 20 時間以降は強度が増加せず、N 規則度は最大で D = 0.06 であった。Fig. 3 に、アニール前後で の試料の磁化曲線を示す。アニールにより磁化は殆ど増えず(1660 ± 90 → 1700 ± 90 emu/cm³)、純 鉄と同程度で巨大な値ではない。しかし、膜中における α "相の体積割合は低いと予想され、 α "相 の飽和磁化を議論するためにはアニール条件を再検討し N 規則度を向上させる必要がある。

【謝辞】本研究は、JSPS 科研費基盤 A(No. 26249037)の助成を受けた。

1) Y. Sugita et al., J. Appl. Phys. 70, 5977 (1991). 2) Y. Takahashi et al., J. Magn. Magn. Mater. 232, 18 (2001).

3) M. Yang et al., Appl. Phys. Lett. 103, 242412 (2013). 4) N. Ji et al., Appl. Phys. Lett. 102, 072411 (2013).



Fig.1 The relation between FWHMs for α -Fe(002) and α '-Fe-N(002).







Fig.3 *M*-*H* loops for Fe-N(97)/Fe(3) /MAO before and after annealing.